

● Structure

Silicon N-channel MOSFET

●Features

- 1) Built-in G-S Protection Diode.
- 2) Small Surface Mount Package (TUMT3).
- 3) Low voltage drive. (4V)

●Application

Switching

●Packaging specifications

Type	Package	Taping
	Code	TL
	Quantity (pcs)	3000
RSF015N06FRA		○

●Absolute maximum ratings (Ta = 25°C)

Parameter		Symbol	Limits	Unit
Drain-source voltage		V_{DSS}	60	V
Gate-source voltage		V_{GSS} *1	± 20	V
Drain current	Continuous	I_D	± 1.5	A
	Pulsed	I_{DP} *1	± 6.0	A
Source current (Body Diode)	Continuous	I_S	0.6	A
	Pulsed	I_{SP} *1	6.0	A
Power dissipation		P_D *2	0.8	W
Channel temperature		T_{ch}	150	°C
Range of storage temperature		T_{stg}	-55 to +150	°C

*1 $P_w \leq 10 \mu s$, Duty cycle $\leq 1\%$

*2 Mounted on a ceramic board.

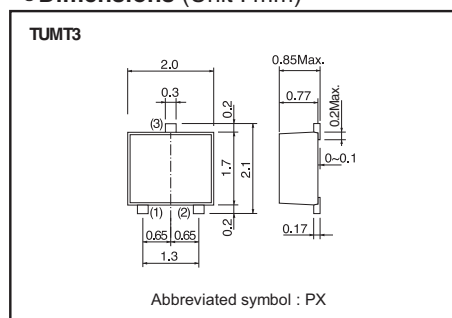
- Thermal resistance

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Channel to Ambient	Rth (ch-a)*	156	°C / W

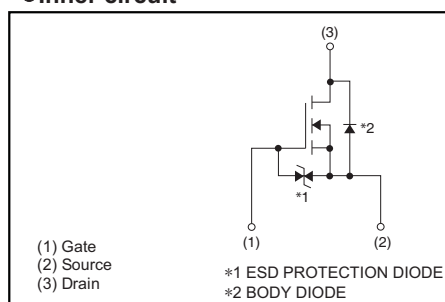
*Mounted on a ceramic board.

●Dimensions (Unit : mm)

AEC-Q101 Qualified



- Inner circuit



●Electrical characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Gate-source leakage	I_{GSS}	-	-	± 10	μA	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	60	-	-	V	$I_D = 1mA, V_{GS} = 0V$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	-	1	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.0	-	2.5	V	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$
Static drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}^*$	-	210	290	m Ω	$I_D = 1.5A, V_{GS} = 10V$
		-	240	330		$I_D = 1.5A, V_{GS} = 4.5V$
		-	255	350		$I_D = 1.5A, V_{GS} = 4.0V$
Forward transfer admittance	$ Y_{fs} ^*$	1.0	-	-	S	$I_D = 1.5A, V_{DS} = 10V$
Input capacitance	C_{iss}	-	110	-	pF	$V_{DS} = 10V$
Output capacitance	C_{oss}	-	28	-	pF	$V_{GS} = 0V$
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	-	12	-	pF	$f = 1MHz$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}^*$	-	6	-	ns	$I_D = 0.7A, V_{DD} = 30V$
Rise time	t_r^*	-	9	-	ns	$V_{GS} = 10V$
Turn-off delay time	$t_{d(off)}^*$	-	15	-	ns	$R_L = 42.8\Omega$
Fall time	t_f^*	-	10	-	ns	$R_G = 10\Omega$
Total gate charge	Q_g^*	-	2.0	-	nC	$I_D = 1.5A$
Gate-source charge	Q_{gs}^*	-	0.8	-	nC	$V_{DD} = 30V$
Gate-drain charge	Q_{gd}^*	-	0.5	-	nC	$V_{GS} = 5V$

*Pulsed

●Body diode characteristics (Source-Drain) (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Forward Voltage	V_{SD}^*	-	-	1.2	V	$I_S = 1.5A, V_{GS} = 0V$

*Pulsed

●Electrical characteristic curves (Ta=25°C)

Fig.1 Typical Output Characteristics(I)

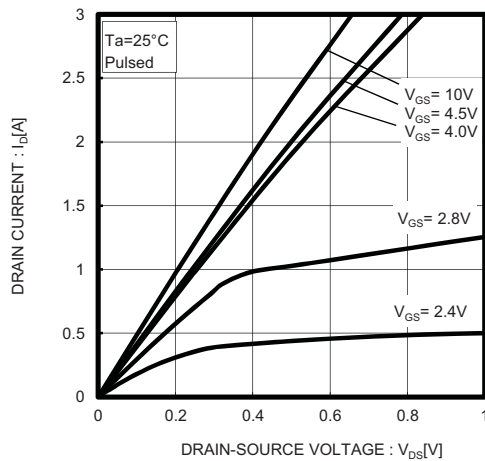


Fig.2 Typical Output Characteristics(II)

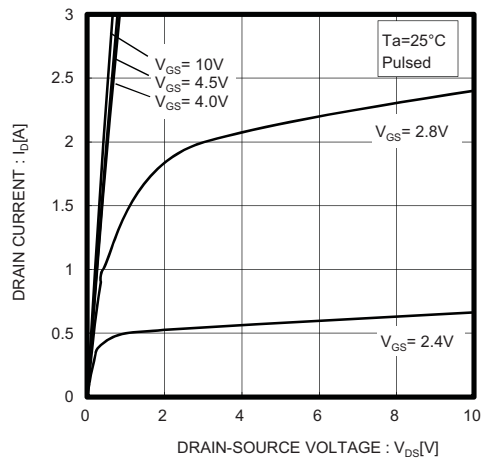


Fig.3 Typical Transfer Characteristics

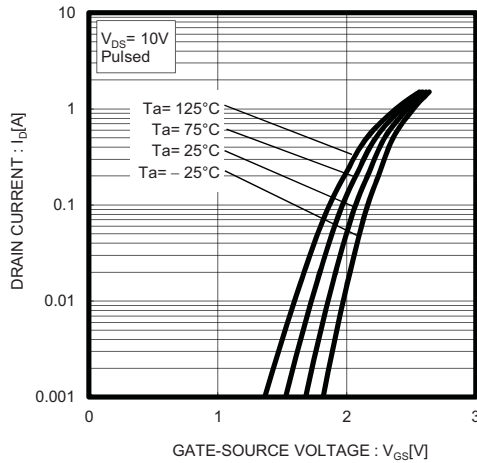


Fig.4 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I)

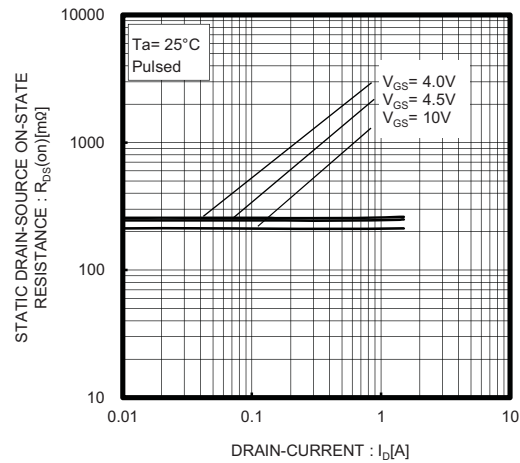


Fig.5 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(II)

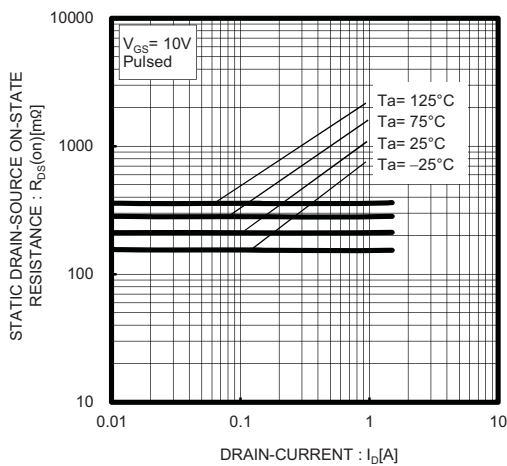


Fig.6 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(III)

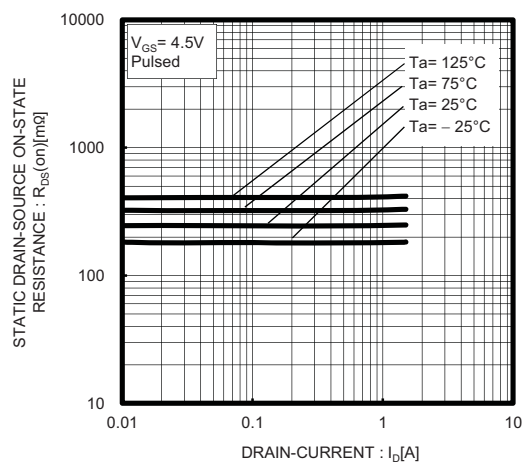


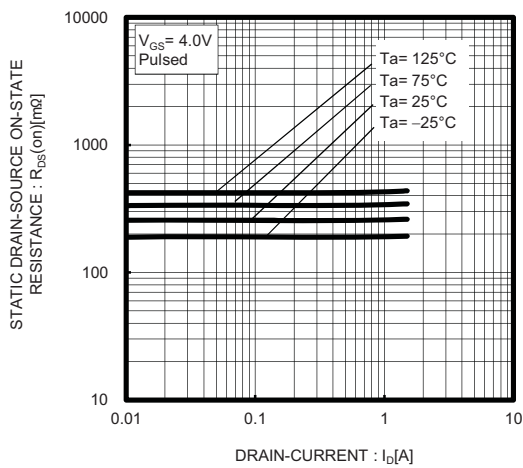
Fig.7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I_D)

Fig.8 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current

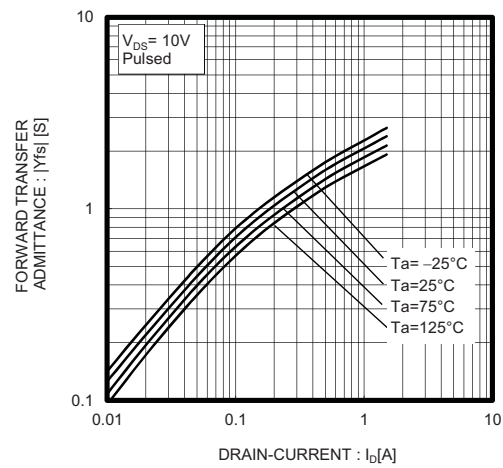


Fig.9 Source Current vs. Source-Drain Voltage

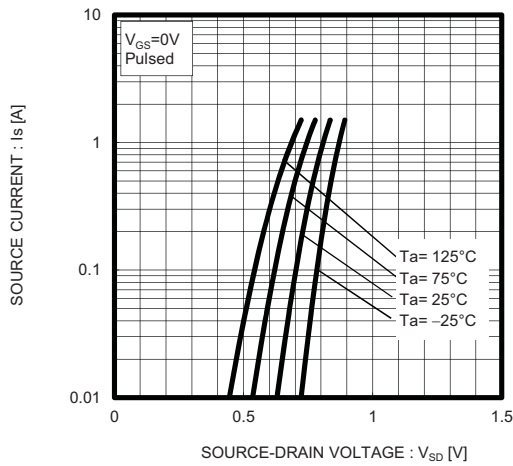


Fig.10 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Gate Source Voltage

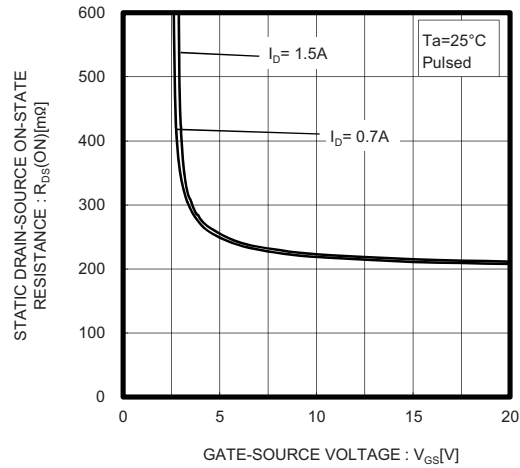


Fig.11 Switching Characteristics

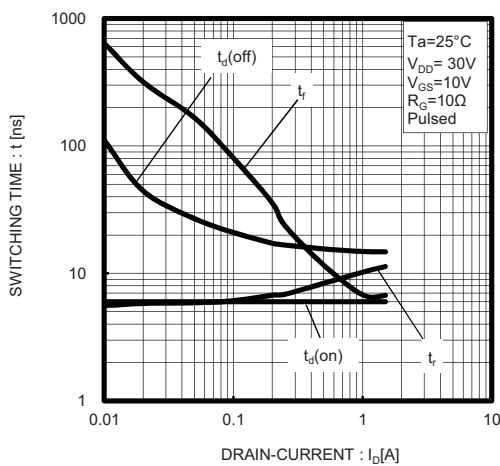


Fig.12 Dynamic Input Characteristics

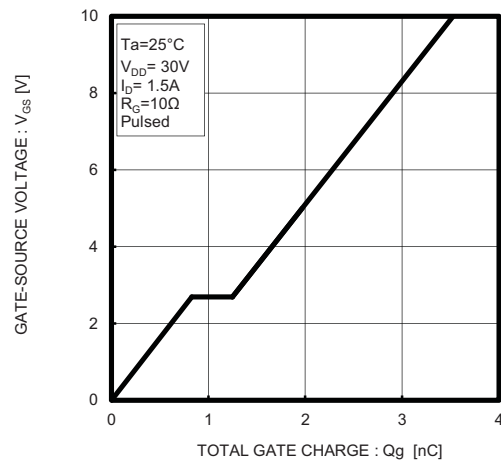
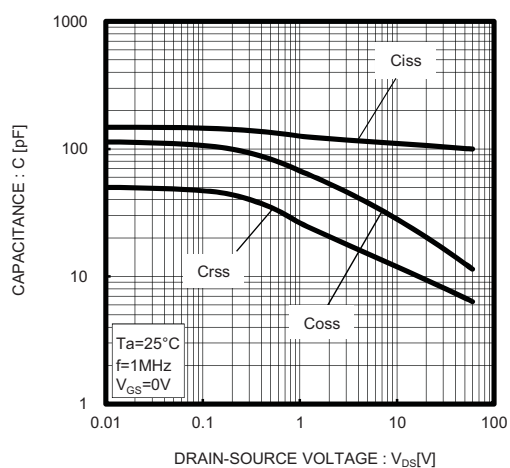


Fig.13 Typical Capacitance
vs. Drain-Source Voltage

●Measurement circuits

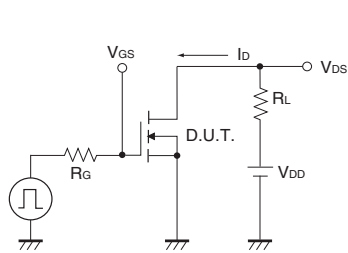


Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit

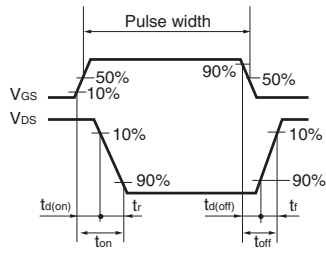


Fig.1-2 Switching Waveforms

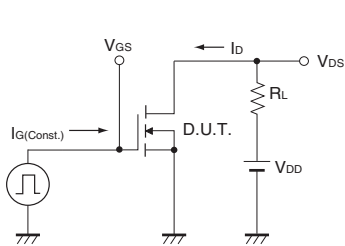


Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit

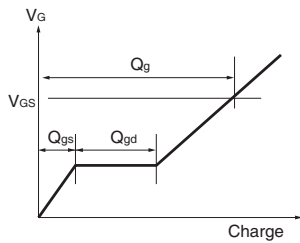


Fig.2-2 Gate Charge Waveform

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9